Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0500U000138

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-05-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пузіков Вячеслав Михайлович
2. Puzikov Vyacheslav Mykhajlovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 19-04-2000

Спеціальність за освітою: 2016

Місце роботи здобувача: Науково-дослідне відділення "Оптичні і конструкційні кристали" НТК "Інститут монокристалів" НАН україни

Код за ЄДРПОУ: 23756545

Місцезнаходження: 61001, Україна, Харків, пр. Леніна, 60

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.169.01

Повне найменування юридичної особи: Інститут монокристалів НАН України

Код за ЄДРПОУ: 00210217

Місцезнаходження: просп. Науки, 60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61072, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Науково-дослідне відділення "Оптичні і конструкційні кристали" НТК "Інститут монокристалів" НАН україни

Код за ЄДРПОУ: 23756545

Місцезнаходження: 61001, Україна, Харків, пр. Леніна, 60

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.19.31, 29.19.33

Тема дисертації:

1. Умови утворення, структура і властивості алмазоподібних плівок вуглецю, осаджених з іонних пучків

2. Formation conditions, structure and properties of diamondlike carbon films deposited from ion beams

Реферат/анотація:

1. Об'єкт дослідження: алмазоподібні плівки вуглецю Мета дослідження: визначення механізмів утворення структур, субструктур, наноструктур і обумовлених ними особливостей електронної структури і фізичних властивостей алмазоподібних плівок вуглецю з високим вмістом sp3 фази. Методи дослідження: осаження плівок з іонних пучків, електронографія, моделювання, оптична спектроскопія, ОЖЕ-спектроскопія, Раманівська спектроскопія, еліпсометрія, електрофізичні вимірювання. Теоретичні та практичні результати, новітність: вперше запропоновано спосіб осадження плівок вуглецю з сепарованих за масою пучків іонів, що дозволило одержати плівок з високим (> 90 %) вмістом sp3 фази, забезпечити їх високу структурну і фазову однорідність, встановити зв'язок структури, субструк-тури, фазового складу, фізичних властивостей плівок з умовами їх осадження. Запропоновані нові принципи побудови струк-турних моделей плівок з високим вмістом sp3 фази. Галузь впровадження: прилади електроніки, оптики і інформатики.

2. Object of investigation: diamond-like carbon films. Purpose of investigation: determination of mechanisms of formation of structures, substructures, nanostructures and caused by them peculiar features of the electron structure and physical properties of diamond-like carbon films with high content of sp3 phase. Investigation methods: films deposition from ion beams, electron microscopy, simulation, optical spectroscopy, Auger-spectroscopy, Raman spectroscopy, ellipsometry, electrophysical measurements Theoretical and practical results, novelty: a method of carbon film deposition from the separated by mass ion beam has been suggested for the first time. This allowed to prepare films with high (>90%) content of sp3 phase, to provide their structural and phase homogeneity, to find a correlation between structure, substructure, phase composition, physical properties of films and conditions of their deposition. New principles of constructing structure models of films with high content of sp3 phase have been proposed. Field of application: devices for electronics, optics and cybernetics

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Новиков М.В.
2. Новиков М.В.

Кваліфікація: д.т.н., 05.03.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Валах М.Я.

2. Валах М.Я.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пугачов А.Т.

2. Пугачов А.Т.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Толмачов О.В.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Толмачов О.В.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.